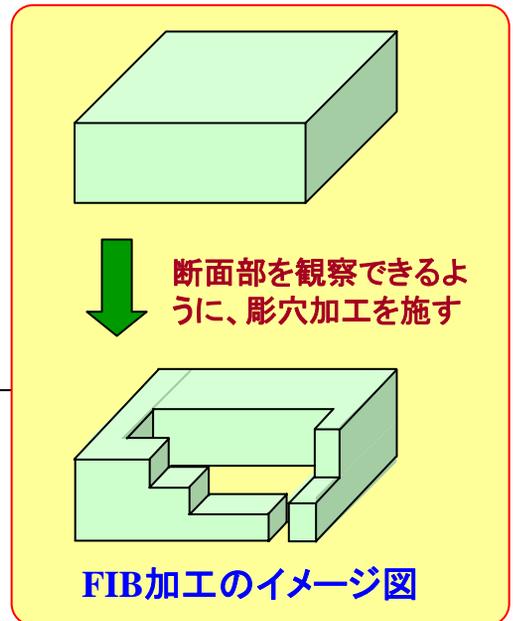


半導体チップの断面観察

<分析手法> FIB(集束イオンビーム)による加工と観察

集束させたGa(ガリウム)イオンをサンプルの特定微小部に照射すると、スパッタ効果により精密な彫穴加工ができます。

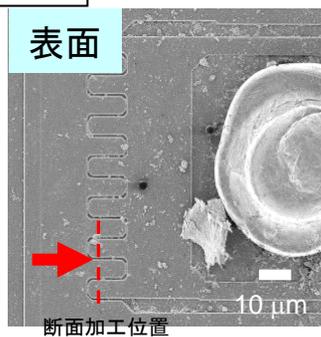
この手法(FIB法)を用いて、静電気強制破壊試験を実施したメモリの断面観察を行いました。



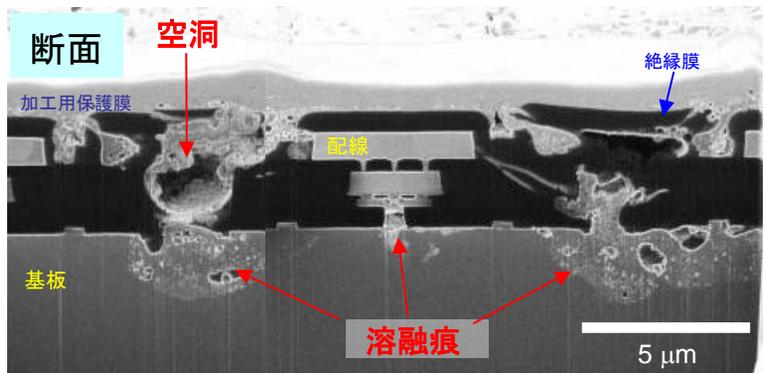
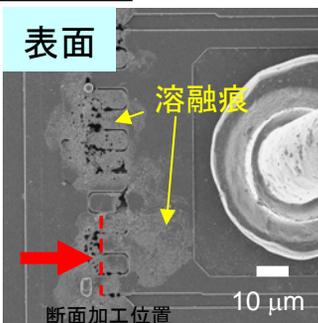
<結果>

静電気強制破壊試験品は、ボンディングパッド近傍の保護回路で配線が溶融し、基板まで変質していることが確認できました。

新品



試験品



SIM (Scanning ion microscope) 像による断面観察